## シリコン表面に担持された白金クラスターディスクによる 極低温NO還元の反応解析

豊田工大 クラスター研究室 安松 久登

## Reaction analysis of low-temperature NO reduction on Pt clusters directly bound to Si substrate surface

Hisato Yasumatsu

Cluster Research Laboratory, Toyota Technological Institute: in East Tokyo Laboratory, Genesis Research Institute, Inc., Japan

**[Abstract]** Surface-chemistry studies are reported, which show that Pt clusters bound to a Si surface function as electron-donation catalysts at low temperatures owing to strong electronic interaction between the Pt clusters and the Si surface. (1) NO reduction and CO oxidation proceed at temperatures lower by ~100 K than bulk and nano materials of Pt. (2) NO is selectively reduced to N<sub>2</sub>, but neither partial reduction to N<sub>2</sub>O nor oxidation to NO<sub>2</sub> occur. (3) A temperature window exists, in which the NO reduction is preferable to the CO oxidation.

【序】Si 表面に担持された Pt クラスター、Pt<sub>N</sub>/Si (クラスターサイズ: N=20-60)、上では、酸素による CO 酸化が、バルク Pt 表面[1]よりも 150 K も低温で進行することを発見した[2,3]。この反応は、O<sub>2</sub>の解離で生成される活性な原子状酸素が CO を酸化する。O<sub>2</sub>の解離は、その反結合性分子軌道への電子捕獲で開始されることを考慮すると、Pt<sub>N</sub>/Si は電子供与性の著しく高い物質と考えられる。実際に、走査型トンネル顕微鏡を用いた局所電子状態密度計測[4]ならびに密度汎関数計算[5]から、Pt<sub>N</sub>の電子がSi に引き寄せられて、Pt<sub>N</sub>と Si 表面とのサブナノ界面に局在していることを明らかにした。この局在電子が高活性な電子供与性触媒の源と解釈している。

金属粒子と担体との強い相互作用(SMSI: Strong Metal-Support Interaction)は、酸 化チタンに担持された白金ナノ粒子などで提唱されており、電子状態の変調や機能性 の多様化などをもたらす[6]。大きなナノ粒子の場合、その構成金属原子のうちで SMSI の影響を受けるのは、担体との界面近傍に限定される。しかし、サイズが百個程度以 下の金属クラスターでは、構成原子の大部分が SMSI の影響を受ける。特に、少なく ともサイズが 40 以下の Pt<sub>N</sub>/Si では、Pt と Si との強い相互作用に由来して Pt<sub>N</sub>が単原 子層で Si と結合しているため[7]、全ての Pt 原子が SMSI の影響を受けている。この 点も、Pt<sub>N</sub>/Si が高い電子供与能力を持つ要因である。

本発表では、 $Pt_N/Si$ が高い NO 還元触媒能力も持つことを報告する。この反応でも、 NOの反結合性分子軌道への電子捕獲によるNとOへの解離が決定的な過程であるため、触媒の電子供与能力がその活性を左右する。主な報告事項は、(1)NO 還元や CO酸化がバルク Pt やナノ Pt 粒子よりも 100 K 以上低温で開始される、(2)NO 還元による  $N_2$  生成が選択的に起こり、 $N_2O$  への部分還元や NO<sub>2</sub> への酸化が起こらない、(3)CO 酸化よりも NO 還元が優先的に起こる温度窓が存在する。これらの結果は、熱効率の 高い酸素過剰での燃焼(リーンバーン)排ガスの浄化触媒に対する新たな提案となる。

【実験】マグネトロンスパッタで  $Pt_N^+$ を生成し、四重極質量フィルターでサイズ選別 した(サイズ選別後の強度は 80-1000 pA)[2]。Pt 原子あたりの衝突エネルギーを 1 eV に設定して Si(111)-7x7 表面に衝撃させることで[8]、単一サイズ  $Pt_N$  を同表面に結 合させた。クラスターの数密度は  $6 \times 10^{12}$  cm<sup>-2</sup>以下のため、基板上でのクラスターの 重なりは無視できる。反応計測では昇温脱離分析(TPD)[3]とガスフロー分析[9]を用 いた。TPD では、100K に冷却した上記試料に対して一定量の NO と CO を吸着させ た後、昇温しながら N<sub>2</sub>や CO<sub>2</sub>の生成量を質量分析により計測した。ガスフロー分析 では、NO・CO・O<sub>2</sub>を同時に連続的に供給しながら N<sub>2</sub>や CO<sub>2</sub>生成量を計測すること により、準定常状態でのターンオーバーレイト(Pt 原子あたりの反応レイト)を温度 の関数として求めた。Pt<sub>N</sub>/Si は 673 K でも安定である[10]。

【結果・考察】Fig. 1 に、Pt<sub>60</sub>/Si 上で進行する NO+CO 反応の TPD スペクトルを示す。 340 K で N<sub>2</sub> と CO<sub>2</sub>が生成されている。この温度は、Pt(111)表面[11]やアルミナに担持 された Pt ナノ粒子(粒径 7 nm)[12]の同反応と比べて 100 K 程度低い。さらに、N<sub>2</sub> と CO<sub>2</sub>の生成温度が同じである。

NOの解離による活性酸素がCOを 酸化することを考慮すると、NOの 解離、COとOとの反応、および、 NとNとの結合によるN<sub>2</sub>の生成が 同じ温度(340 K)で起こっている ことを示している。すなわち、こ の反応の律速はNOの解離であり、 NとNとの結合ではない。講演で は、NOの還元選択性、および、 NO・CO・O<sub>2</sub>同時供給時のNO+CO 反応とO<sub>2</sub>+CO反応選択性に関して も報告する。



**Fig. 1.** TPD spectra of  $N_2$  (blue) and  $CO_2$  (green) produced in an NO+CO reaction catalyzed on  $Pt_{60}/Si$ .

## 【参考文献】

- [1] J. Yoshinobu and M. Kawai, J. Chem. Phys. 103, 3220 (1995).
- H. Yasumatsu, "Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry", ed. Klaus Wandelt (Editor-in-Chief), Elsevier, pp. 477-489 (2018).
- [3] H. Yasumatsu and N. Fukui, J. Phys. Chem. C 119, 11217 (2015).
- [4] H. Yasumatsu, T. Hayakawa and T. Kondow, Chem. Phys. Lett. 487, 279 (2010).
- [5] H. Yasumatsu, P. Murugan and Y. Kawazoe, Phys. Stat. Solidi B 6, 1193 (2012).
- [6] C.-J. Pan et al. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 74, 154 (2017).
- [7] H. Yasumatsu, T. Hayakawa, S. Koizumi and Tamotsu Kondow, J. Chem. Phys. 123, 124709 (2005).
- [8] H. Yasumatsu and T. Kondow, Rep. Prog. Phys. 66, 1783 (2003).
- [9] H. Yasumatsu and N. Fukui, Catal. Sci. Technol. 6, 6910 (2016).
- [10] N. Fukui and H. Yasumatsu, Eur. Phys. J. D 67, 81 (2013).
- [11] Y. Ohno et al. Chem. Phys. Lett. 373, 161 (2003).
- [12] E. I. Altman and R. J. Gorte, J. Phys. Chem. 93, 1993 (1989).